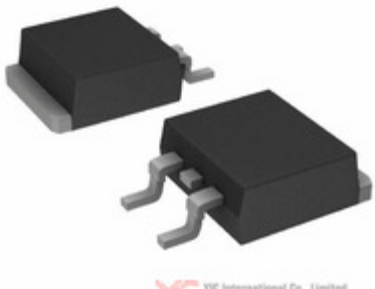
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB027N10N5ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1.IPB027N10N5ATMA1.pdf</a>  <a href="#">2.IPB027N10N5ATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB027N10N5ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 184µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10300pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	139nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB027N10N5ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB027N10N5ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB027N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB027N10N5ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB027N10N3 G</b> INFINEON IPB027N10N3 G INFINEON</p>	 <p><b>IPB029N06N3GE8187ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p><b>IPB026N06NATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 25A TO263-3</p>	 <p><b>IPB027N10N3G</b> INFINEON IPB027N10N3G INFINEON</p>
 <p><b>IPB029N06N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p><b>IPB029N06N3G(032N06N)</b> INFINEON IPB029N06N3G(032N06N) INFINEON</p>	 <p><b>IPB027N10N3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 120A TO263-3</p>	 <p><b>IPB026N06N(026N06N)</b> INFINEON IPB026N06N(026N06N) INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB027N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB027N10N5ATMA1 Datenblatt	IPB027N10N5ATMA1-Datenblätter	IPB027N10N5ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB027N10N5ATMA1
IPB027N10N5ATMA1 Electronic	IPB027N10N5ATMA1-Komponenten	IPB027N10N5ATMA1-Verteiler	IPB027N10N5ATMA1-Bild	IPB027N10N5ATMA1-Teil
IPB027N10N5ATMA1 Preis	IPB027N10N5ATMA1 Hersteller	IPB027N10N5ATMA1 Bild	IPB027N10N5ATMA1 Aktie	IPB027N10N5ATMA1 Inventar
IPB027N10N5ATMA1 Neu	IPB027N10N5ATMA1 Original	IPB027N10N5ATMA1 garantiert	IPB027N10N5ATMA1 RFQ	IPB027N10N5ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited